

Silicon Diode

BYT56D

200V / 3A

DATASHEET

OEM – Telefunken

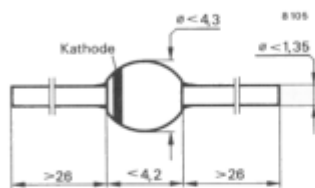
Source: Telefunken Databook 1988

BYT 56.**Silizium-Mesa-Dioden**

Anwendungen: Sehr schnelle Gleichrichter und Schalter

Besondere Merkmale:

- Glaspassivierte Sperrschicht
- Niedriger Sperrstrom
- Hermetisch dichtes Gehäuse
- Soft-recovery-Verhalten

Abmessungen in mm

Sinterglasgehäuse
SOD 64
Gewicht max. 1,0 g

Bestempelung: Klartext

Absolute Grenzdaten

Sperrspannung, Periodische Spitzensperrspannung

BYT 56 A	$U_R = U_{RRM}$	50	V
BYT 56 B	$U_R = U_{RRM}$	100	V
BYT 56 D	$U_R = U_{RRM}$	200	V
BYT 56 G	$U_R = U_{RRM}$	400	V
BYT 56 J	$U_R = U_{RRM}$	600	V
BYT 56 K	$U_R = U_{RRM}$	800	V
BYT 56 M	$U_R = U_{RRM}$	1000	V

Surge forward current

$t_p = 10 \text{ ms}$	I_{FSM}	80	A
-----------------------	-----------	----	---

Durchlaßstrom, Mittelwert

$I = 10 \text{ mm}, T_L = 25 \text{ °C}$	Fig. 2, 4 I_{FAV}	1,5	A
--	---------------------	-----	---

	Fig. 3 I_{FAV}	3	A
--	------------------	---	---

Sperrschichttemperatur

T_j	175	°C
-------	-----	----

Lagerungstemperaturbereich

T_{stg}	- 65 ... + 175	°C
-----------	----------------	----

Maximale Wärmewiderstände

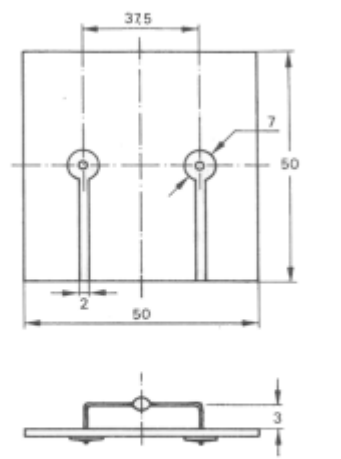
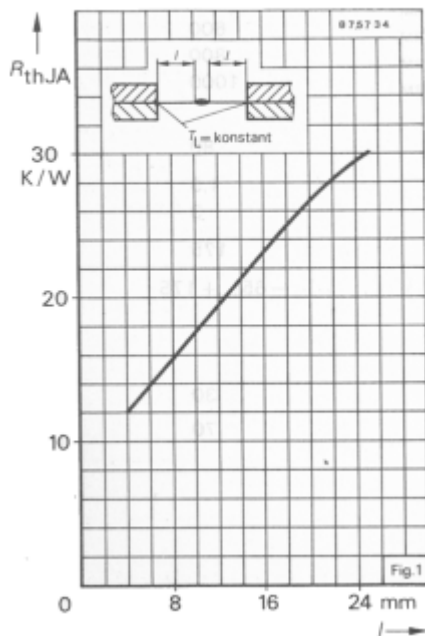
Sperrschicht-Umgebung

$l = 25 \text{ mm}, T_L = \text{konstant}$	Fig. 1 R_{thJA}	30	K/W
--	-------------------	----	-----

auf Leiterplatte im Raster 37,5 mm	Fig. 2 R_{thJA}	70	K/W
------------------------------------	-------------------	----	-----

BYT 56.

Kenngrößen		Min.	Typ.	Max.
$T_j = 25\text{ °C}$, falls nicht anders angegeben				
Durchlaßspannung	$I_F = 3\text{ A}$			
	U_F			1,4 V
Sperrstrom	$U_R = U_{RRM}$			5 μA
	$U_R = U_{RRM}$, $T_j = 150\text{ °C}$			150 μA
Rückwärtserholzeit	$I_F = 0,5\text{ A}$, $I_R = 1\text{ A}$, $i_R = 0,25\text{ A}$			100 ns
	t_{rr}			

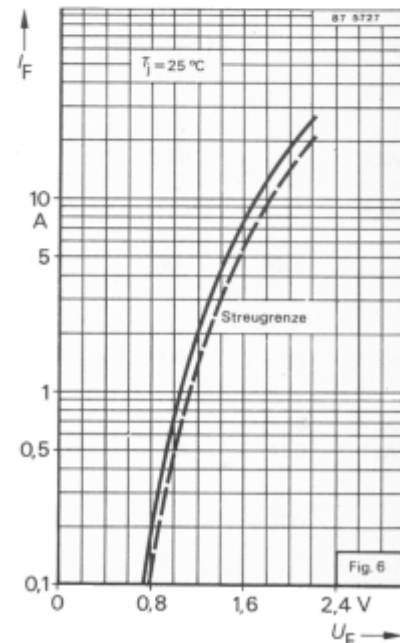
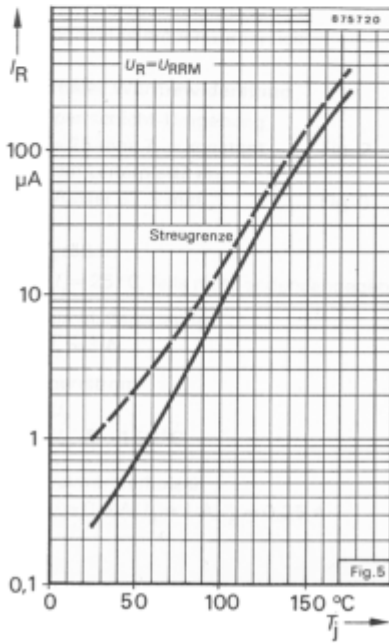
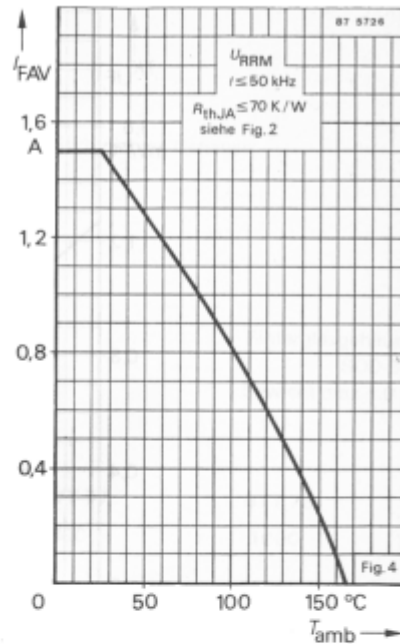
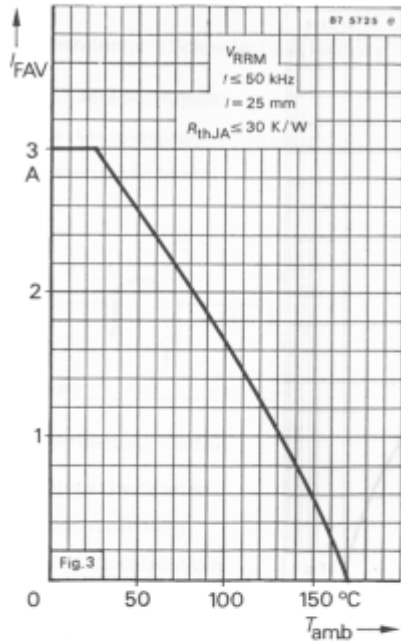


Epoxy Glas Hartgewebe, Plattenstärke: 1,5 mm
 $R_{thJA} \leq 70\text{ K/W}$

Fig 2

875735

BYT 56.



BYT 56.